

FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS :

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_c=25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_c=25^\circ\text{C}$)										外 形	備 考
				V_{ce0} (V)	V_{be0} (V)	I_c (mA)	P_c (mW)	T_c ($^\circ\text{C}$)	I_{c0} 最大値 (μA)	直流又はパルス h_{FE}		バイアス		h_{FE}	h_{ie} h_{ie}^* (Ω)	h_{re} h_{re}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{oe}^* (μS)	$f_{\alpha b}$ $f_{\alpha b}^*$ (Mc)		
1	2	3	4	5					6		7		8				9	10	11	12

- 1 TYPE NUMBER
- 2 ORIGINAL MANUFACTURER
- 3 USES
- 4 MATERIAL AND STRUCTURE
- 5 MAXIMUM RATINGS
- 6 I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})
- 7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE} , I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})
- 8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

- * INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.
- 9 $f_{\alpha b}$ OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T .
- 10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)
- 11 OUTLINE
- 12 REMARKS

: とコンプリ : COMPLEMENTARY TO

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)										外 形	備 考					
				V_{CB0} (V)	V_{EB0} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CB0} 最大値		直流又はパルス h_{FE}		バ イ ア ス		h_{fe} h_{fb}^*	h_{ie} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μU)			f_{β} f_T^* (Mc)	C_{ob} (pF)	r_{bb} $h_{ie}(\text{real})^*$ (Ω)		
									μA	$V_{CB}(V)$	$V_{CE}(V)$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB}(V)$	$I_E(\text{mA})$										h_{fb}^*	h_{ib}^*
2SD987	日電	SW	Si.T	500	8	5 A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	400	>100	2	3 A									268	ダーリントン		
" 988																									
" 989																									
" 990																									
" 991																									
" 992	日電	PA. SW	Si.E	30	5	2 A	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	20	> 50	5	500										186		
" 993	三洋	SW	Si.TMe	1500	6	3 A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1 mA	1500	10	5	2 A										102	水平偏向用	
" 994	"	"	"	1500	6	8 A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	1000	10	5	5 A										102	水平偏向用	
" 995	"	"	"	2500	6	3 A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1 mA	2500	10	10	1.5A										102	水平偏向用	
" 996																									
" 997	日電	PA	Si.T	250	5	10A	200W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	50	200	80	5	2 A	5	-200						15 *	300	102	2SB796 とコンプリ	
" 998	"	"	Si.E	100	8	1.5A	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	60	7000	2	500											225	ダーリントン
" 999	"	"	"	30	5	1 A	2 W (セラミック基板使用)	150	0.1	30	200	1	100	6	-10									336	2SB798 とコンプリ
" 1000	"	"	"	60	5	700	2 W (セラミック基板使用)	150	0.1	60	200	1	100	6	-10									336	2SB799 とコンプリ
" 1001	"	AF	"	80	5	300	2 W (セラミック基板使用)	150	0.1	80	200	1	50	6	-10									336	2SB800 とコンプリ
" 1002																									
" 1003																									
" 1004																									
" 1005	日電	AF	Si.E	100	5	1 A	2 W (セラミック基板使用)	150	0.1	100	200	2	100	5	-10									336	2SB804 とコンプリ
" 1006	"	"	"	100	5	700	2 W (セラミック基板使用)	150	0.1	100	200	1	100	10	-10									336	2SB805 とコンプリ
" 1007	"	"	"	120	5	700	2 W (セラミック基板使用)	150	0.1	120	200	1	100	10	-10									336	2SB806 とコンプリ
" 1008																									
" 1009	松下	AF	Si.EP	150	5	50	1 W (プリント基板使用)	150	1	100	90~450	5	10	10	-10									336	2SB807 とコンプリ
" 1010	"	"	"	50	15	50	300	125	0.1	20	400~2000	10	2											138	
" 1011	"	"	"	100	15	20	300	125	0.1	50	400~2000	10	2											138	
" 1012	三洋	PA	"	20	5	700	250	125	1	15	160~960	2	50	10	-50									92	2SB808 とコンプリ
" 1013																									
" 1014																									
" 1015	ソニー	SW	Si.E	140	50	2 A	900	150	2	100	150~1500	2	10											259	双方向性
" 1016	三洋	"	Si.TMe	1500	6	7 A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	40	1000	7	5	4 A											102	水平偏向用

逆方向電流増幅率: $h_{FE} \sim 150 \sim 1500$
($V_{CE} = 2 \text{ V}$, $I_E = 10 \text{ mA}$)

$V_{no} = 80 \text{ mV}$
(10 V , 1 mA , $R_G = 100 \text{ k}\Omega$, $C_G = 80 \text{ pF}$)